

4Ср 8	<u>А.А. Добрецова</u> , А.Д. Шепелянский, З.Д. Квон, С. Герон, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий Необычное поведение уровней Ландау в 20нм HgTe квантовой яме
4Ср 9	<u>М.В. Дорохин</u> , Ю.М. Кузнецов, И.В. Ерофеева, В.П. Лесников, А.В. Здоровейщев, А.В. Боряков Влияние состава на термоэлектрические свойства тонких плёнок MnSi_x
4Ср 10	<u>М.П. Духновский</u> , Е.Н. Куликов, Ю.Ю. Федоров Тепловой барьер на границе раздела алмаз-металл, причины его возникновения и пути его снижения
4Ср 11	<u>И.В. Ерофеева</u> , М.В. Дорохин, А.В. Здоровейщев, Ю.М. Кузнецов, А.А. Попов, Е.А. Ланцев, А.В. Боряков, В.Е. Котомина Получение электроимпульсным плазменным спеканием термоэлектрических материалов на основе Si и Ge
4Ср 12	<u>И.Ю. Забавичев</u> , А.А. Потехин, А.С. Пузанов, С.В. Оболенский, В.А. Козлов Рейжинжиниринг диодных структур по результатам измерений их характеристик
4Ср 13	И.В. Алтухов, <u>М.С. Каган</u> , С.К. Папроцкий, Н.Б. Родионов, А.П. Большаков, В.Г. Ральченко, Р.А. Хмельницкий Транспорт в алмазных вертикальных диодах
4Ср 14	И.В. Алтухов, <u>М.С. Каган</u> , С.К. Папроцкий, Н.А.Хвальковский, И.С. Васильевский, А.Н. Винниченко Электрические домены в сверхрешетках GaAs/AlAs с распределенным ТГц резонатором
4Ср 15	<u>И.Л. Калентьева</u> , О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, Б.Н. Звонков, А.В. Кудрин, И.Н. Антонов Влияние состава газа-носителя в процессе роста дельта-слоя Mn на электрические и магнитные свойства GaAs структур
4Ср 16	В.П.Евтихийев, Г. Позина, М.И. Митрофанов, Я.В. Левицкий, Г.В. Вознюк, Е.Е. Татаринев, В.Н. Калитеевский, А.Р. Губайдуллин, С.Н. Родин, Л.С. Чечурин, <u>М.А. Калитеевский</u> Селективная эпитаксия планарных субмикронных структур
4Ср 17	<u>Э.А. Коблов</u> , М.В. Ревин, Д.С. Смотрин, В.А. Иванов, Е.В. Демидов, М.Н. Дроздов, П.А. Юнин, Л.Д. Молдавская, В.И. Шашкин Влияние параметров канального слоя на электрофизические и структурные параметры рНЕМТ-гетероструктур (Al-In-Ga)As, выращенных методом МОГФЭ
4Ср 18	<u>В.А. Козлов</u> , Д.Г. Павельев, В.А. Вербус, С.В. Оболенский, Е.С. Оболенская Резонансные туннельные контакты для гетероструктур AlAs/GaAs